

(公財) 科学技術交流財団
第3回「次世代デバイス実現に向けた
先端二次元物質の物理と化学」研究会 開催案内

- 1 日 時：平成29年1月25日（水） 13：30－18：00（予定）
- 2 会 場：科学技術交流財団 研究交流センター 次ページご参照
（名古屋市中村区名駅4-4-38 愛知県産業労働センター（ウイंकあいち）15階）
- 3 連絡先：（公財）科学技術交流財団
- 4 内 容：
 - <13:30 ～ 13:35>
◇座長挨拶： 名古屋大学 大学院工学研究科 マテリアル理工学専攻
准教授 柚原 淳司 氏
 - <13:35 ～ 14:35>
◇特別講演：「IV 族二次元材料とそのヘテロ構造の形成」
北陸先端科学技術大学院大学 マテリアルサイエンス系
准教授 高村(山田) 由起子 氏
 - <14:35 ～ 15:15>
◇招待講演1：「トポロジカル絶縁体とトポロジカル超伝導」
名古屋大学 大学院工学研究科 マテリアル理工学専攻 教授 田仲 由喜夫 氏
 - <15:15 ～ 15:30> 休憩
 - <15:30 ～ 16:00>
◇招待講演2：「絶縁膜上にある IV 族二次元結晶の電子状態解析」
名古屋大学 未来材料・システム研究所 助教 洗平 昌晃 氏
 - <16:00 ～ 16:30>
◇招待講演3：「絶縁基板上における IV 族半導体薄膜の結晶方位制御技術：
二次元物質への展開」
名古屋大学 未来材料・システム研究所 特任講師 黒澤 昌志 氏
 - <16:30 ～ 16:55>
◇招待講演4：「水素終端シリセン・ゲルマネン・スタネンナノリボンのエッジ状態」
名古屋大学 大学院工学研究科 マテリアル理工学専攻 服部 綾実 氏
 - <17:55 ～ 17:00>
◇総括、次回予告： 座長
 - <17:00 ～ 18:00>
◇交流会（ライトパーティー）